

## Ⅱ－４．半導体製造装置・試験装置、マスク・レチクル 及び半導体プロセス材料

### Ⅱ－４－１ 様式選択ガイド

(1/2)

利用に際しては関係法令を熟知の上、下記の項目に対応する適切な様式を選択してください。

[種類]	[関係省令番号]	[パラメータシート 様式番号]
半導体製造装置・ 試験装置及び マスク・レチクル	結晶のエピタキシャル成長装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号イ <a href="#">6-17-1/イ</a>
	イオン注入装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ロ <a href="#">6-17-2/ロ</a>
	マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ホ <a href="#">6-17-5/ホ</a>
	リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号へ、ヲ <a href="#">6-17-6/へヲ</a>
	半導体試験装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ヌ <a href="#">6-17-7/ヌ</a>
	EUVペリクルの製造装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ル <a href="#">6-17-8/ル</a>
	EUVリソグラフィ用に設計された成膜、塗布、ベーク 若しくは現像装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ワ <a href="#">6-17-9/ワ</a>
	ドライエッチング用に設計した装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号カ <a href="#">6-17-10/カ</a>
	ウェットエッチング用に設計した装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号コ <a href="#">6-17-11/コ</a>
	異方性エッチング用に設計した装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号タ <a href="#">6-17-12/タ</a>
	成膜装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号レ <a href="#">6-17-13/レ</a>
	金属の層を成膜する装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号 ソ、ツ、ネ <a href="#">6-17-14/ソツネ</a>
	プラズマを用いウエハーを回転させ、原子レベルで 成膜する装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ナ <a href="#">6-17-15/ナ</a>
	シリコン及び炭素を含む膜の成膜装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ラ <a href="#">6-17-16/ラ</a>
	EUVマスク用の多層反射膜の成膜装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ム <a href="#">6-17-17/ム</a>
	シリコン若しくはシリコンゲルマニウムのエピタキシャル 成長装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ウ <a href="#">6-17-18/ウ</a>
	カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的 気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号キ <a href="#">6-17-19/キ</a>
	タンゲステン膜のプラズマ成膜装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ノ <a href="#">6-17-20/ノ</a>

## Ⅱ-4-1 様式選択ガイド

(2/2)

利用に際しては関係法令を熟知の上、下記の項目に対応する適切な様式を選択してください。

[種類]	[関係省令番号]	[パラメータシート 様式番号]
半導体製造装置・ 試験装置及び マスク・レチクル	金属配線間を埋めるプラズマ成膜装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号オ <a href="#">6-17-21/オ</a>
	アニール装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ク <a href="#">6-17-22/ク</a>
	洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ヤ <a href="#">6-17-23/ヤ</a>
	ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の 除去を行う洗浄除去装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号マ <a href="#">6-17-24/マ</a>
	乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号ケ <a href="#">6-17-25/ケ</a>
	EUVマスクブランク若しくはパターン付きEUVマスクの 検査装置又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号フ <a href="#">6-17-26/フ</a>
	マスク・レチクル・インプリントリソグラフィテンプレート 又はその部分品若しくは附属品	第6条第十七号 ト、チ、リ <a href="#">6-17-27/トチリ &amp;9-13の2</a>
	EUVペリクル(マスク若しくはレチクル 又はこれら部分品若しくは附属品)	第9条第十七号の二 <a href="#">6-17の2</a>
	マスクの製造に用いられる基材	第6条第十七号の三 <a href="#">6-17の3</a>
	半導体素子又は集積回路の画像を取得するために 設計した走査型電子顕微鏡	第6条第十七号の四 <a href="#">6-17の4</a>
	その他の(半導体素子、集積回路若しくは半導体 物質の)製造装置若しくは試験装置 又はこれらの部分品若しくは附属品	<a href="#">6-17-MS C</a>
半導体プロセス 材料	半導体基板	第6条第十八号 <a href="#">6-18/-22/-23/-24</a>
	レジスト又はそれを塗布した基板	第6条第十九号 <a href="#">6-19</a>
	有機金属化合物又は有機化合物	第6条第二十号 <a href="#">6-20</a>
	燐、砒素又はアンチモンの水素化物	第6条第二十一号 <a href="#">6-21</a>
	炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、 窒化アルミニウムガリウム、三酸化ニガリウム、 ダイヤモンドの半導体基板又はインゴット、ブール その他のプリフォーム	第6条第二十二号 <a href="#">6-18/-22/-23/-24</a>
	多結晶基板	第6条第二十三号 <a href="#">6-18/-22/-23/-24</a>
	エピタキシャル層を有する基板	第6条第二十四号 <a href="#">6-18/-22/-23/-24</a>
医療用除外	医療用に設計された装置又は医療用に設計された装置に組み込まれたもの	<a href="#">0-01貨</a>

リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号へ、ヲ

貨物名：  
 メーカー名：  
 型及び銘柄：

パラメータシート  
 エレクトロニクス・貨物  
 様式:6-17-6/へ、ヲ (1/3)  
 CISTEC 2024.09.08  
 (令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
<p>へ リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品か？</p> <p>(解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。</p> <p>貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
<p>(一) ウエハの処理のためのステップアンドリピート方式又はステップアンドスキャン方式の露光装置であって、光学方式のもの又はエックス線を用いたものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←(二)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>1 光源の波長が193ナノメートル未満のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 波長 ( )nm ↓	<input checked="" type="checkbox"/> はい 波長 ( )nm ←判定結果へ	
<p>2 ナノメートルで表した光源の波長に0.35を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 数値 ( ) ←ヲへ	<input checked="" type="checkbox"/> はい 数値 ( ) ←判定結果へ	
<p>(二) インプリントリソグラフィ装置であって、45ナノメートル以下の線幅を実現することができるものか？</p> <p>(解釈) 「インプリントリソグラフィ装置」: マイクロコンタクトプリンティング装置、ホットエンボシング装置、ナノインプリントリソグラフィ装置及びステップアンドフラッシュインプリントリソグラフィ装置を含む。</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 数値 ( )nm ←(三)へ	<input checked="" type="checkbox"/> はい 数値 ( )nm ←判定結果へ	
<p>(三) マスクの製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビーム、イオンビーム又はレーザー光を用いたものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←(四)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>1 照射面の半値全幅の直径が65ナノメートル未満かつ、イメージ位置誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が17ナノメートル未満のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 直径 ( )nm 誤差 ( )nm ↓	<input checked="" type="checkbox"/> はい 直径 ( )nm 誤差 ( )nm ←判定結果へ	
<p>2 削除</p>			
<p>3 マスク上の2層目の重ね合わせ誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が23ナノメートル未満のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 誤差 ( )nm ↓	<input checked="" type="checkbox"/> はい 誤差 ( )nm ←判定結果へ	

リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号へ、ヲ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-6/へ、ヲ (2/3)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
<p>(四) 直接描画方式で半導体素子又は集積回路の製造をすることができるように設計した装置であって、電子ビームを用いたものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>1 照射面の直径が15ナノメートル以下のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 直径 ( _____ )nm ↓	<input checked="" type="checkbox"/> はい 直径 ( _____ )nm ←判定結果へ	
<p>2 重ね合わせ誤差(平均値に3シグマを加えたもの)が27ナノメートル以下のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 誤差 ( _____ )nm ←判定結果へ	<input checked="" type="checkbox"/> はい 誤差 ( _____ )nm ←判定結果へ	
<p>ヲ 光学式の露光装置又はその部分品若しくは附属品であって、光源の波長が193ナノメートル以上のものか？ (へ(一)2に該当するものを除く。)</p> <p>(解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。</p> <p>貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←へ(二)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( _____ ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
<p>(一) ナノメートルで表した光源の波長に0.25を乗じて得た数値を開口数の値で除して得た数値が45以下のものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 数値 ( _____ ) ←へ(二)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 数値 ( _____ )	
<p>(二) 同一装置による重ね合わせ精度の最大値が2.4ナノメートル以下のものか？</p> <p>(解釈) 「第十七号ヲ(二)中の同一装置による重ね合わせ精度」: ウエハの既存のパターン上に、新しいパターンを形成する際に、両方のパターンを同一の装置で形成する場合の重ね合わせ精度をいう。</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 数値 ( _____ ) ←へ(二)へ	<input checked="" type="checkbox"/> はい 数値 ( _____ ) ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: <input type="checkbox"/> 省令第6条第十七号へ ( _____ ) <input type="checkbox"/> 省令第6条第十七号ヲ [( _____ ) に該当項目を記入する]		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。

注2: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号へ、ヲ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-6/へ、ヲ

(3/3)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者： (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

印

電話

成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号レ

貨物名：  
 メーカー名：  
 型及び銘柄：

パラメータシート  
 エレクトロニクス・貨物  
 様式：6-17-13/レ (1/4)  
 CISTEC 2024.09.08  
 (令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回答	備考	
レ 半導体製造装置の成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？ (解釈) 「部分品・附属品」：他の用途に用いることができるものを除く。 貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かで判断する。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。(理由)
(一) 電気メッキ又は無電解メッキによりコバルトを成膜するように設計したものか？ (解釈) 「第十七号レ (一)中の成膜するように設計したもの」：半導体ウエハーの処理を行う装置に限る。	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい	
(二) 化学的気相成長法によりコバルトを充填するように設計したもの又は選択性のボトムアップ成膜を用いる化学的気相成長法によりタングステンを充填するように設計したものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ←Bへ	
(三) 単一のチャンバー内での複数の工程によって金属のコンタクト層を成膜するように設計した装置か？ ((二)に該当するものを除く。)	<input type="checkbox"/> いいえ ←(a.1)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
1 ウエハーの基板温度を100度超500度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いてタングステンの層を成膜するものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(a.1)へ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( )°C ↓	
2 水素(水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。)を用いたプラズマによる工程を有するものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい	
A. (「特定半導体製造装置」の判定)			
a.1 複数のチャンバー又はステーション内での複数の工程によって成膜するものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←Bへ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
a.2 複数の工程間において0.01パスカル以下の真空状態又は不活性の環境を維持することができるように設計したものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←Bへ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
A-1. 金属のコンタクト層を成膜するように設計したものか？ ((四)、(五)、(七)は、(二)に該当するものを除く。)	<input type="checkbox"/> いいえ ←A-2へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	

成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号レ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-13/レ (2/4)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
(四) 1 ウエハーの基板温度を100度超500度未満に維持しながら、水素(水素と窒素又はアンモニアとの混合物を含む。)を用いたプラズマにより表面処理を行う工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもののか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(五)へ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( _____ )°C ↓	
	<input type="checkbox"/> いいえ ←(五)へ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( _____ )°C ↓	
	<input type="checkbox"/> いいえ ←(五)へ	<input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black;">はい</span> ウエハー基板温度 ( _____ )°C ↓	
(五) 1 リモートプラズマ源及びイオンフィルターを用いて表面処理を行う工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもののか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(七)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
	<input type="checkbox"/> いいえ ←(七)へ	<input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black;">はい</span> ↓	
(七) 1 ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、有機金属化合物を用いて窒化チタン又は炭化タングステンの層を成膜する工程により金属のコンタクト層を成膜するように設計したもののか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←A-2へ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( _____ )°C ↓	
	<input type="checkbox"/> いいえ ←A-2へ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( _____ )°C 圧力 ( _____ )Pa ↓	
	<input type="checkbox"/> いいえ ←A-2へ	<input type="checkbox"/> <span style="border: 1px solid black;">はい</span> ウエハー基板温度 ( _____ )°C 圧力 ( _____ )Pa ↓	
A-2 銅配線を形成するように設計したもののか？ ( (八)は、(二)に該当するものを除く。 )	<input type="checkbox"/> いいえ ←Bへ	<input type="checkbox"/> はい ↓	

成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号レ

パラメータシート  
 エレクトロニクス・貨物  
 様式:6-17-13/レ (3/4)  
 CISTEC 2024.09.08  
 (令和6年9月8日施行省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
(ハ) 1 ウエハーの基板温度を20度超500度未満に維持しながら、133.3パスカル超13.33キロパスカル未満の圧力で有機金属化合物を用いてコバルト又はルテニウムの層を成膜する工程により銅配線を形成するように設計したものか？  2 ウエハーの基板温度を500度未満に維持しながら、0.1333パスカル超13.33パスカル未満の圧力で物理的気相成長法を用いて銅の層を成膜する工程により銅配線を形成するように設計したものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←Bへ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( )°C 圧力 ( )Pa ↓	
<input type="checkbox"/> いいえ ←Bへ	<input type="checkbox"/> はい ウエハー基板温度 ( )°C 圧力 ( )Pa ↓		
B. (原子層堆積装置の判定)			
(六) 仕事関数金属(トランジスタの閾値電圧を制御するための材料をいう。以下同じ。)を原子層堆積法により成膜するように設計した装置か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(九)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
1 2以上の金属の供給源を有するもののうち、アルミニウムの前駆体用に設計した供給源を1以上有するか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(九)へ	<input type="checkbox"/> はい 金属供給源の数 ( ) アルミ前駆体用の供給源の数 ( ) ↓	
2 30度超の温度で作動するように設計した前駆体容器を有するものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(九)へ	<input type="checkbox"/> はい 作動温度 ( )°C ↓	
3 仕事関数金属を成膜するように設計した装置か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(九)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
一 炭化チタンアルミニウムを成膜するものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←(九)へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
二 4.0電子ボルト超の仕事関数を可能とするものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ( )eV ↓	
(九) 有機金属化合物を用いてバリアー膜又はライナーを選択的に成膜するように設計した原子層堆積装置か？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ↓	
(解釈) 「第十七号レ(九)中 下地の導電体との界面にバリア膜を用いずに充填金属を形成させることを可能とするバリア膜を選択的に成膜することができるものを含む。」			



成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号レ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-13/レ (4/4)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
(十) ウエハーの基板温度を500度未満に維持しながら、配線の全体又は絶縁膜と絶縁膜との隙間(幅が40ナノメートル未満のものに限る。)にタングステンを原子層堆積法により充填するように設計した原子層堆積装置か?  ((十)は、(二)に該当するものを除く。)  (解釈) 「第十七号レ (十)中の幅」: 最表面における幅をいう。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input checked="" type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号レ ( ) [ ( ) ]に該当項目を記入する]		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。

注2: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

注3: 第6条第十七号レについては、該・非に拘わらずフローに従い(十)まで確認する。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

印

電話

シリコン及び炭素を含む膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号ラ

貨物名：  
 メーカー名：  
 型及び銘柄：

パラメータシート  
 エレクトロニクス・貨物  
 様式:6-17-16/ラ (1/2)  
 CISTEC 2024.09.08  
 (令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
<p>ラ シリコン及び炭素を含む膜を形成するように設計した成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？</p> <p>(解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。</p> <p>貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。</p> <p>(解釈) 「第十七号ラ中の幅」: 最表面における幅をいう。</p> <p>(解釈) 「第十七号ラ中の成膜装置」: シリコン及び炭素を含有し、かつ、ゲート電極の側壁を覆う膜を成膜するために設計したものに限る。</p> <p>(成膜条件の判定)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
<p>比誘電率が5.3未満の膜を形成できるか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ 比誘電率 ( ) ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 比誘電率 ( ) ↓	
<p>幅が70ナノメートル未満であり、当該幅に対する深さの比率が5倍を超える開口部の側壁に膜を形成できるか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>パターンのピッチが100ナノメートル未満の構造のものに膜を形成できるか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>(装置構成の判定)</p>			
<p>(一) ウエハーが設置された空間とは異なる空間で発生させたラジカルにより化学反応を促進させることで成膜する成膜装置か？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
<p>(二) 400度超650度未満の温度で成膜する成膜装置か？                  ((一)に該当するものを除く。)</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>1 垂直方向に積み重なった複数のウエハーを保持するように設計されたポートを有するものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
<p>2 2以上の垂直方向に伸びるインジェクターを有するものか？</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	

シリコン及び炭素を含む膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号ラ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-16/ラ

(2/2)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

質 問 事 項	回	答	備 考
3 膜のシリコン原料及びプロペンが導入されるインジェクターと膜の窒素原料又は膜の酸素原料が導入されるインジェクターが異なるものか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input checked="" type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号ラ ( )		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。

注2: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

印

電話

カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置  
又はその部分品若しくは附属品  
輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号中

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17-19/中 (1/1)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
中 カーボンハードマスクをプラズマを用いた化学的気相成長法により成膜するように設計した装置又はその部分品若しくは附属品か？  (解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。  貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入  本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
厚さが100ナノメートル超であり、かつ、応力が450メガパスカル未満の成膜装置か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号中		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。  
注2: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)  
会社名  
所属・役職  
(フリガナ)  
氏名  
電話

印

金属配線間を埋めるプラズマ成膜装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号オ

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17-21/オ (1/1)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
オ 金属配線間の隙間に低誘電層を空隙が生じないようにプラズマを用いて成膜するように設計した装置設計した成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？  (解釈) 「部分品・附属品」：他の用途に用いることができるものを除く。  貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入  本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
金属配線の隙間は幅が25ナノメートル未満であり、かつ、当該幅に対する深さの比率が1倍以上か？  (解釈) 「第十七号オ中の幅」：最表面における幅をいう。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
成膜される低誘電層は比誘電率が3.3未満か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等： 省令第6条第十七号オ		

注1： 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。

注2： 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者： (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

電話

印

洗淨除去装置又はその部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号ヤ

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17-23/ヤ (1/1)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
ヤ 高分子残さ及び銅酸化膜を除去し、かつ銅の成膜(以下、「その工程」)を可能にするように設計した洗淨除去装置又はその部分品若しくは附属品か？  (解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。 貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要不可欠であるか否かで判断する。  (解釈) 「第十七号ヤ中の洗淨除去装置」: 成膜装置を除く。	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
0. 01パスカル以下の真空状態において、「その工程」が可能な装置か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号ヤ		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。  
注2: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名 印

電話

ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の除去を行う  
洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品  
輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号マ

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17-24/マ

(1/2)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回答		備考
マ ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の除去を行うように設計した洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品か？  (解釈) 「部分品・附属品」: 他の用途に用いることができるものを除く。  貨物等省令第6条第十七号の柱書の「部分品・附属品」の判定基準は、第十七号に該当の半導体製造装置に専用に設計されたものであって、該当となる機能・特性に必要な不可欠であるか否かで判断する。  A. (不純物の除去工程の判定)	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓ 部分品・附属品の場合は本体装置名を記入 本体装置名 ( ) 以下本体装置で判定	「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。 (理由)
ドライプロセスにより表面の酸化物を除去する前処理を行うように設計したのか？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ←Bへ	
ドライプロセスにより表面の汚染物を除去するように設計したのか？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ←Bへ	
B. (装置の構成の判定) 複数のチャンバー又はステーションを有する装置か？  (解釈) 「第十七号マ中の <u>複数のチャンバー又はステーションを有する洗浄除去装置</u> 」:  表面の酸化物を除去する前処理又は表面の汚染物の除去を行うチャンバー又はステーションが、他の処理を行うチャンバー又はステーションと独立しているもの(他の処理を行うチャンバー又はステーションが存在しないものを含む。)に限る。  次のいずれかに該当するものを除く。 イ 不活性ガスを用いた物理的な手法によるもの ロ レジストを除去するために設計したもの ハ 成膜装置	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> はい ←判定結果へ	
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号マ		

注1: 回答の下の( )内には、該・非に拘わらず本体装置名を記入する。数値は、設計値、カタログ又は仕様書等の数値を記入する。  
注2: 回答欄右欄の「  はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の除去を行う  
洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品  
輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号マ

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17-24/マ

(2/2)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者： (作成年月日 年 月 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名 印

電話



半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した  
走査型電子顕微鏡

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号の四

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17の4

(1/2)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

質問事項	回	答	備考
<p>(7の項(16)、省令第6条第十七号の四) 半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した走査型電子顕微鏡か？</p> <p>除外条件 国際半導体製造装置材料協会が定めたSEMI規格に準拠したウエハの搬送・保管容器(200ミリメートル以上のフロント・オープニング・ユニファイド・ポッド(F OUP)を含む。)用にウエハ搬入部を設計したものを除く。</p> <p>(解釈) 「第十七号の四中 チップの設計の復元用に設計の走査型電子顕微鏡」:</p>	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	<p>「いいえ」を選択した場合は、その理由を記すこと。(理由)</p>
イ ステージの位置決め精度が30ナノメートル未満か？	<input type="checkbox"/> いいえ 位置決め精度 ( )nm ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 位置決め精度 ( )nm ↓	
ロ レーザー干渉計によるステージ位置計測が可能か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
ハ レーザー干渉計による長さスケール計測に基づく視野の位置校正が可能か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ↓	
ニ 画素数が200,000,000を超える画像の収集及び保存が可能か？	<input type="checkbox"/> いいえ 画素数 ( ) ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 画素数 ( ) ↓	
ホ 画像を取得する際の視野の重なりが垂直方向及び水平方向で5パーセント未満か？	<input type="checkbox"/> いいえ 視野の重なり ( )% ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 視野の重なり ( )% ↓	
ヘ 画像を結合する際の視野の重なりが50ナノメートル未満か？	<input type="checkbox"/> いいえ 視野の重なり ( )nm ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 視野の重なり ( )nm ↓	
ト 加速電圧が21キロボルトを超えるか？	<input type="checkbox"/> いいえ 加速電圧 ( )kV ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい 加速電圧 ( )kV ←判定結果へ	

半導体素子又は集積回路の画像を取得するために設計した  
走査型電子顕微鏡  
輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号の四

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式:6-17の4

(2/2)

CISTEC 2024.09.08

(令和6年9月8日施行省令等対応)

判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	<input type="checkbox"/> 該当	
該当項番	① 輸出令別表第1の7の項(16) ② 貨物等省令の条項等の番号等: 省令第6条第十七号の四		

注1: 回答欄右欄の「 はい」にチェックされた場合は該当と判定される。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。

作成責任者: (作成年月日 2024 年 8 月 27 日)

会社名

所属・役職

(フリガナ)

氏名

印

電話

その他の(半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の)  
製造装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品

輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七号(イ、ロ、ホ、ヘ、ヌ、ル、ヲ、ワ、カ、ヨ、タ、レ、ソ、ツ、ネ、  
ナ、ラ、ム、ウ、ヰ、ノ、オ、ク、ヤ、マ、ケ、フ)、省令第6条第十七号の四

貨物名：  
メーカー名：  
型及び銘柄：

パラメータシート  
エレクトロニクス・貨物  
様式：6-17-MSC (1/1)  
CISTEC 2024.09.08  
(令和6年9月8日施行省令等対応)

判定項目		様式
イ	結晶のエピタキシャル成長装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-1/イ
ロ	イオン注入装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-2/ロ
ホ	マルチチャンバー対応ウエハー搬送中央装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-5/ホ
ヘ、ヲ	リソグラフィ装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-6/ヘヲ
ヌ	半導体試験装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-7/ヌ
ル	EUVペリクルの製造装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-8/ル
ワ	EUVリソグラフィ用に設計された成膜、塗布、ベーク若しくは現像装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-9/ワ
カ	ドライエッチング用に設計した装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-10/カ
ヨ	ウェットエッチング用に設計した装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-11/ヨ
タ	異方性エッチング用に設計した装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-12/タ
レ	成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-13/レ
ソ、ツ、ネ	金属の層を成膜する装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-14/ソツネ
ナ	プラズマを用いたウエハーを回転させ、原子レベルで成膜する装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-15/ナ
ラ	シリコン及び炭素を含む膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-16/ラ
ム	EUVマスク用の多層反射膜の成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-17/ム
ウ	シリコン若しくはシリコンゲルマニウムのエピタキシャル成長装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-18/ウ
ヰ	カーボンハードマスク用プラズマを用いた化学的気相成長成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-19/ヰ
ノ	タンゲステン膜のプラズマ成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-20/ノ
オ	金属配線間を埋めるプラズマ成膜装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-21/オ
ク	アニール装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-22/ク
ヤ	洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-23/ヤ
マ	ドライプロセスにより前処理として表面の不純物の除去を行う洗浄除去装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-24/マ
ケ	乾燥を行う工程を有する枚葉式のウェット洗浄装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-25/ケ
フ	EUVマスクブランク若しくはパターン付きEUVマスクの検査装置又はその部分品若しくは附属品か？	様式：6-17-26/フ
十七号の四	半導体素子又は集積回路の画像取得するために設計した走査型電子顕微鏡か？	様式：6-17の4
質問事項		回答
上記の輸出令別表第1の7の項(16)及び省令第6条第十七号のいずれかに該当する半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品か？	<input type="checkbox"/> いいえ ↓	<input type="checkbox"/> はい ←関連様式へ
上記の輸出令別表第1の7の項(16)及び省令第6条第十七号の四に該当する走査型電子顕微鏡か？	<input type="checkbox"/> いいえ ←判定結果へ	<input type="checkbox"/> はい ←関連様式へ
判定結果	<input type="checkbox"/> 非該当	

注1: 質問事項及び関係法令を確認の上、上記の回答欄の「いいえ」又は「はい」の内にチェックする。  
注2: 回答欄が「はい」の場合、本パラメータシートではなく、当該貨物のパラメータシート(関連様式)にて判定する。  
注3: 回答欄が「いいえ」の場合、判定結果欄の「非該当」の内にチェックする。

検討の結果、以上のとおり相違ありません。 作成責任者： (作成年月日 年 月 日)  
会社名  
所属・役職  
(フリガナ)  
氏名 印  
電話